

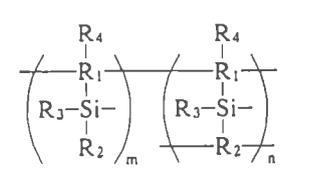
付

特許・実用新案登録一覽

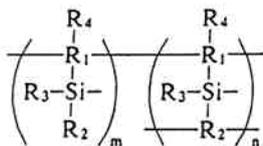
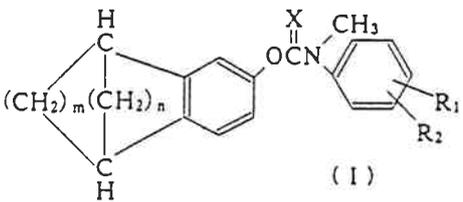
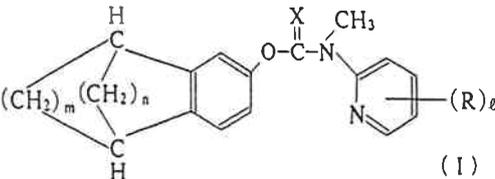
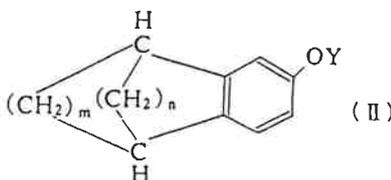
—昭和63年度—

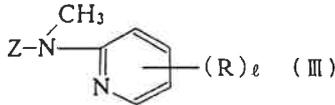
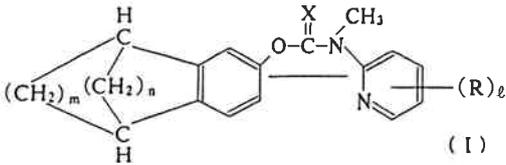
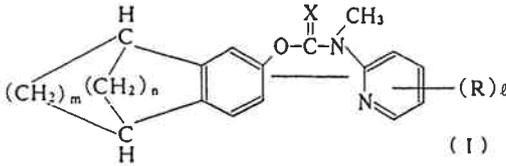
〈日本特許〉 79件

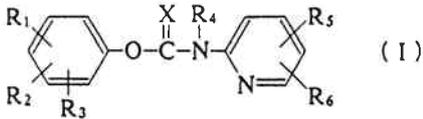
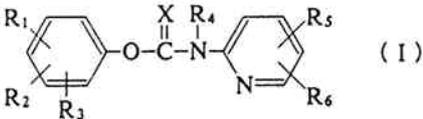
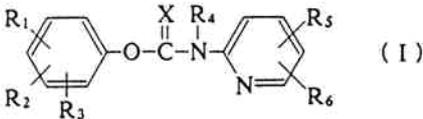
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
1	56-173810 (56.10.30) (藤本輝雄)	62-27848 (62.6.17)	1419803 (63.1.14)	両性イオン交換体及びその製造法	<p>1 陽イオン交換基をもつ高分子鎖 A^- と陰イオン交換基をもつ高分子鎖 B^+ とイオン交換基をもたない高分子鎖 C とからなる三元ブロックポリマーにおいて、該高分子鎖 A^- と高分子鎖 B^+ とが互に隣り合わないよう直鎖状に連結され、かつ上記の陽イオン交換基をもつ高分子鎖 A^- および陰イオン交換基をもつ高分子鎖 B^+ はイオン交換基を含まない原ポリマー換算で夫々全体の5%以上を占め又上記のイオン交換基をもたない高分子鎖 C はイオン交換基を含まない原ポリマー換算で全体の30~90%を占めていることを特徴とする両性イオン交換体。</p> <p>2 重合によって陽イオン交換基をもつことのできる高分子ブロック A を生成しうるモノマーと、同じく重合によって陰イオン交換基をもつことのできる高分子ブロック B を生成しうるモノマーと、同じく重合によってイオン交換基をもたない高分子ブロック C を生成しうるモノマーとをリビングアニオン重合法によって陽イオン交換基をもつことのできる高分子ブロック A と陰イオン交換基をもつことのできる高分子ブロック B とがイオン交換基をもたない高分子ブロック C によって互に隔離されるように順次直鎖状にブロック共重合せしめて陽イオン交換基をもつことのできる高分子ブロック A 及び陰イオン交換基をもつことのできる高分子ブロック B を夫々重量比で生成ブロック共重合体全体に対し5%以上含有し、かつイオン交換基をもたない高分子ブロック C の重量比が生成マルチブロック共重合体全体に対し30~90%である原マルチブロック共重合体を作り、得られる原マルチブロック共重合体に対し高分子ブロック A に陽イオン交換基を導入してこれを陽イオン交換基をもつ高分子鎖 A^- とする工程、高分子ブロック B に陰イオン交換基を導入してこれを陰イオン交換基をもつ高分子鎖 B^+ とする工程及び高分子ブロック C を架橋してイオン交換基をもたない高分子鎖 C とする工程を行うことを特徴とする陽イオン交換基をもつ高分子鎖 A^- と陰イオン交換基をもつ高分子鎖 B^+ とが互に隣り合わないようイオン交換基をもたない高分子鎖 C によって隔離された両性イオン交換体を製造する方法。</p>
2	53-141174 (53.11.17) (蔵本村山)	61-46501 (61.10.14) (憲一, 上野 浩)	1421666 (63.1.29) 喜美	被覆有機顔料	<p>1 フタロシアニン、アンスラキノン、ペリレン又はアゾ系顔料の粒子核上に複数個の界面活性剤分子の親水基又は疎水基を吸着させ、界面活性剤層を形成し、該核上の界面活性剤空隙部分に不溶性金属塩を充填し、充填層を形成し、かつ界面活性剤の親水基に二価以上の金属イオンを結合してなる被覆有機顔料。</p>

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
3	57-127280 (57. 11. 27) (近藤 溝口)	62-34689 (62. 7. 28) (徳矩, 小林 順造)	1423972 (63. 2. 15) (洋治)	半水石こうの水和方法	1 ストロンチウムを含む半水石こうを水和して二水石こうを得るにあたり、該半水石こうをSO ₄ 濃度≧5wt%, O≦P ₂ O ₅ /SO ₄ (重量比)<1の組成を有する硫酸又は硫酸とリン酸の混合酸と接触させたのち水と接触させて水和させることを特徴とする半水石こうの水和方法。
4	54-79123 (54. 6. 25) (河村 浅野)	62-29092 (62. 6. 24) (秀雄, 宮之原 精一)	1424475 (63. 2. 15) (勲)	硫黄系悪臭物質の除去剤の製造方法	1 鉄およびマンガン塩の酸性混合水溶液を20分以内でpH8以上に調整して、鉄およびマンガンの酸化物を析出させた後、該成分を主成分としてバインダーの不存在下、造粒・成型することを特徴とする硫黄系悪臭物質の除去剤の製造方法。
5	50-157879 (50. 12. 27) (加藤 清田)	62-30995 (62. 7. 6) (芳男, 橋本 徹, 清水 明彦)	1427049 (63. 2. 25)	核酸塩基、ヌクレオシド及びヌクレオチドの分離方法	1 核酸塩基、ヌクレオシド及びヌクレオチドをクロマトグラフィーで分離する方法において、担体としてエポキシ基を含む多孔性ゲルに核酸塩基を結合せしめた担体を使用することを特徴とする核酸塩基、ヌクレオシド及びヌクレオチドの分離方法。
6	53-131593 (53. 10. 27) (宮之原 水井 規雅, 前田 一)	62-35968 (62. 8. 5) (勲, 諸藤 正光)	1427093 (63. 2. 25)	重炭酸ナトリウムの製造法	1 反応器内の液体の温度及び組成が均一となるようにほぼ完全混合状態にある完全混合型の反応装置に、下記の(1)式と(3)式又は(2)式と(3)式で表わされる範囲内の濃度を有する炭酸ナトリウム又は水酸化ナトリウムの水溶液と、二酸化炭素又は二酸化炭素含有ガスを連続的に供給して、常に器内の液組成を重曹析出領域に維持しつつ、40~100°Cの温度において反応を行い、重炭酸ナトリウムを析出させる事の特徴とする重炭酸ナトリウムの製造法。 $-0.727x+22 \leq y \leq -1.03x+32.5 \quad (1)$ $-0.60x+18.2 \leq z \leq -0.88x+25 \quad (2)$ $0 \leq x \leq 20 \quad (3)$ (ただし、上式中yは炭酸ナトリウム濃度(重量%), zは水酸化ナトリウム濃度(重量%), xは塩化ナトリウム濃度(重量%)を表す。)
7	53-139422 (53. 11. 14) (小宮 深野 克夫, 佐々木博朗 一幸)	62-33550 (62. 7. 21)	1427098 (63. 2. 25)	イオン交換液体クロマトグラフィー用担体およびその製法	1 シリカゲル担体細孔表面のシラノール基Siと下記一般式(I)SiとがSi-O-Siにより結合されていることを特徴とするイオン交換液体クロマトグラフィー用担体。 一般式(I)  $\left(\begin{array}{c} R_4 \\ \\ R_1 \\ \\ R_3-Si- \\ \\ R_2 \end{array} \right)_m - \left(\begin{array}{c} R_4 \\ \\ R_1 \\ \\ R_3-Si- \\ \\ R_2 \end{array} \right)_n \quad (I)$ {R ₁ ; C-C, C-O, C-H および O-H の結合または C-C, C-O, C-H, O-H および C-X (X; ハロゲン原子) の結合 (ハロゲン原子含有量は20重量%以下) で構成され、Siとは Si-C 結合からなり、CとOの原子比(C/O)が2.5以下の有機基, R ₂ ; R ₁ と同じ有機基, メトキシ基, エトキシ基または水酸基, R ₃ ; メチル基, エチル基, メトキシ基, エトキシ基または水酸基, R ₄ ; A-B-C で示される分子量400以下の

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
					<p>有機基 (A:イオン交換基で第1級アミノ基, 第2級アミノ基, 第3級アミノ基, 第4級アンモニウム塩基, グアニド基, これらを含むポリアミノ基, カルボキシル基, スルホン酸基またはリン酸基, B:炭素数1ないし4の脂肪族基または炭素数3ないし18のエチレンオキサイドもしくはプロピレンオキサイドのオリゴマーまたはポリオール骨格を有するポリエーテル基, C:エーテル結合, 第2級アミノ基, 第3級アミノ基, エステル結合, C-C結合により R₁と結合している)</p> <p>m; 1以上の整数, n; 0または1以上の整数}</p> <p>2 シリカゲル担体細孔表面のシラノール基と一般式 (II)</p> $ \begin{array}{c} R_5 \quad R_7 \\ \diagdown \quad / \\ Si \\ / \quad \diagdown \\ R_6 \quad R_8 \end{array} \quad (II) $ <p>{R₅; エポキシ基を有し構成原子の原子量の総和が57~147の有機基, R₆; R₅と同じ有機基, メトキシ基, エトキシ基またはハロゲン原子, R₇, R₈; メチル基, エチル基, メトキシ基, エトキシ基またはハロゲン原子}</p> <p>で表されるオルガノシランを担体およびオルガノシランに不活性な溶媒の存在下あるいは非存在下, 20°C ないし 300°C で反応させ Si-O-Si 結合を形成し, 次いで C-C, C-O, C-H および O-H の結合または C-C, C-O, C-H, O-H および C-X (X; ハロゲン原子) の結合 (ハロゲン原子含有量は20重量%以下) で構成され, CとOの原子比 (C/O) が2.5以下, 分子量1000以下かつエポキシ当量 (分子量/エポキシ基の数) 350以下のエポキシ基含有有機物および</p> <p>一般式 A-B-D</p> <p>{A:イオン交換基で第1級アミノ基, 第2級アミノ基, 第3級アミノ基, 第4級アンモニウム塩基, グアニド基, これらを含むポリアミノ基, カルボキシル基, スルホン酸基またはリン酸基, B; 炭素数1ないし4の脂肪族基または炭素数3ないし18のエチレンオキサイドもしくはプロピレンオキサイドのオリゴマーまたはポリオール骨格を有するポリエーテル基, D; 水酸基, エポキシ基, 第1級アミノ基, 第2級アミノ基, カルボン酸基, ハロゲン原子または水素原子}</p> <p>で示され, かつ分子量400以下のイオン交換基を有する有機物をオルガノシラン処理担体と, これらに不活性な溶媒中で, 触媒の存在下あるいは非存在下, -20°C ないし 200°C で共重合または付加反応させることを特徴とするシリカゲル担体細孔表面のシラノール基 Si と下記一般式 (I) Si とが Si-O-Si により結合されているイオン交換液体クロマトグラフィー用担体の製法。</p>

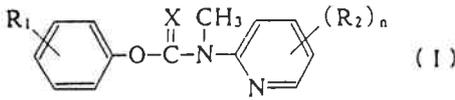
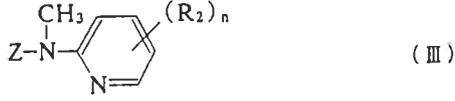
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
					 <p style="text-align: right;">(I)</p> <p>{R₁, R₂, R₃, R₄, m, n; 前記に同じ}</p>
8	54-63236 (54. 5. 24) (武本)	62-36056 (62. 8. 5) 勝雄, 村山	1427124 (63. 2. 25) 浩)	ポリオレフィン成形物の表面改質法	1 塩化ビニリデン単量体単独雰囲気下又は塩化ビニリデンおよびこれと共重合可能な単量体との混合雰囲気下でポリオレフィン系重合体成形物に光を照射して前記単量体を前記重合体成形物にグラフト重合することを特徴とするポリオレフィン系重合体成形物の表面改質法。
9	57-106737 (57. 6. 23) (竹松)	62-34002 (62. 7. 24) 哲夫, 近内	1427322 (63. 2. 25) 誠登	カーバメート誘導体を含有する除草剤	<p>1 一般式 (I) :</p>  <p style="text-align: right;">(I)</p> <p>(式中, mは1または2を, nは0, 1または2を示す。ただしnが0のとき -(CH₂)_n- が結合している二個の炭素には -(CH₂)_n- に代りそれぞれ水素原子が結合するものとする。Xは酸素原子または硫黄原子を, R₁ および R₂ は各々水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基またはトリフルオルメチル基を示し, 互に同一または相異なる。) で表わされるカーバメート誘導体を有効成分として含有することを特徴とする除草剤。</p>
10	57-129651 (57. 7. 27) (竹松)	62-37035 (62. 8. 10) 哲夫, 近内	1427330 (63. 2. 25) 誠登	カーバメート誘導体	<p>1 一般式 (I) :</p>  <p style="text-align: right;">(I)</p> <p>(式中, mは1又は2を示し, nは0, 1又は2を示し, Xは酸素原子又は硫黄原子を示し, Rは水素原子, ハロゲン原子又は低級アルキル基を示し, lは1又は2を示す。ただしnが0の場合, -(CH₂)_n- が結合している2個の炭素には -(CH₂)_n- に代り, それぞれ水素原子が結合するものとする。) で表わされるカーバメート誘導体。</p> <p>2 一般式 (II)</p>  <p style="text-align: right;">(II)</p>

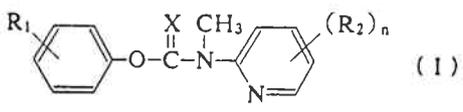
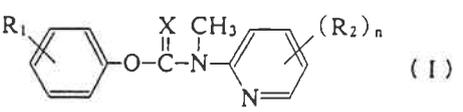
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
					<p>(式中、Yは水素原子、ハロカルボニル基又はハロチオカルボニル基であり、mは1又は2、nは0、1又は2を示す。ただし、nが0の場合は $-(CH_2)_n-$ が結合している二個の炭素には $-(CH_2)_{n-}$ に代り、それぞれ水素原子が結合するものとする。) で表わされるフェノール誘導体を</p> <p>一般式 (III)</p>  <p>(III)</p> <p>(式中、Zは(II)式のYが水素原子のときハロカルボニル基又はハロチオカルボニル基であり(II)式のYがハロカルボニル基又はハロチオカルボニル基のとき水素原子である。Rは水素原子、ハロゲン原子又は低級アルキル基を示し、lは1又は2を示す。) で表わされるアミノピリジン誘導体と反応させることを特徴とする</p> <p>一般式 (I)</p>  <p>(I)</p> <p>(式中、mは1又は2、nは0、1又は2を示し、Xは酸素原子又は硫黄原子を示し、Rは水素原子、ハロゲン原子又は低級アルキル基を示し、lは1又は2を示す。ただしnが0の場合、$-(CH_2)_n-$ が結合している2個の炭素には $-(CH_2)_{n-}$ に代り、それぞれ水素原子が結合するものとする。) で表わされるカーバメート誘導体の製造法。</p> <p>3 一般式 (I)</p>  <p>(I)</p> <p>(式中、mは1又は2を示し、nは0、1又は2を示し、Xは酸素原子又は硫黄原子を示し、Rは水素原子、ハロゲン原子又は低級アルキル基を示し、lは1又は2を示す。ただしnが0の場合、$-(CH_2)_n-$ が結合している2個の炭素には $-(CH_2)_{n-}$ に代り、それぞれ水素原子が結合するものとする。) で表わされるカーバメート誘導体を有効成分として含有することを特徴とする除草剤。</p>

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
11	58-34651 (58. 3. 4) (竹松 森中 中西 橋濱)	62-34756 (62. 7. 28) 哲夫, 近内 秀夫, 野中 明, 続木 充幸, 魚谷	1427351 (63. 2. 25) 誠登 悠次 建治 武)	カーバメート誘導体	<p>1 一般式 (I) :</p>  <p>(式中, R₁ および R₂ はハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基, 低級アルケニルオキシ基, 低級アルキニルオキシ基, 低級アルキルチオ基, ニトロ基またはアシル基を示し, R₃ は水素原子または低級アルキル基を示し, R₄ は低級アルキル基を示し, R₅ は水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基または低級アルキルアミノ基を示し, R₆ は水素原子または低級アルキル基を示し, Xは酸素原子または硫黄原子を示す。)</p> <p>で表わされるカーバメート誘導体。</p> <p>2 一般式 (II) :</p> <p>低級アルキル基を示し, R₅ は水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基または低級アルキルアミノ基を示し, R₆ は水素原子または低級アルキル基を示す。)</p> <p>で表わされるアミノピリジン誘導体と反応させることを特徴とする</p> <p>一般式 (I) :</p>  <p>(式中, R₁ および R₂ はハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基, 低級アルケニルオキシ基, 低級アルキニルオキシ基, 低級アルキルチオ基, ニトロ基またはアシル基を示し, R₃ は水素原子または低級アルキル基を示し, R₄ は低級アルキル基を示し, R₅ は水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基または低級アルキルアミノ基を示し, R₆ は水素原子または低級アルキル基を示し, Xは酸素原子または硫黄原子を示す。)</p> <p>で表わされるカーバメート誘導体の製造法。</p> <p>3 一般式 (I) :</p>  <p>(式中, R₁ および R₂ はハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基, 低級アルケニルオキシ基, 低級アルキニルオキシ基, 低級アルキルチオ基, ニトロ基またはアシル基を示し, R₃ は水素原子または低級アルキル基を示し, R₄ は低級アルキル基を示し, R₅ は水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基または低級アルキルアミノ基を示し, R₆ は水素原子または低級アルキル基を示し,</p>

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
					Xは酸素原子または硫黄原子を示す。) で表わされるカーバメート誘導体を有効成分として含有することを特徴とする除草剤。
12	61-177598 (61. 7. 30) (近藤 赫文, 柳原 忠久)	62-32183 (62. 7. 13)	1427367 (63. 2. 25)	ジエン系含フッ素化合物の製法	<p>1 1, 2-ジクロロ-1, 2-ジフルオロエチレンと炭素数 1~3 の飽和アルコールのテロメル化反応によって得られる</p> <p>一般式</p> $H(C_2F_2Cl_2)_2-Y-OH$ <p>(Yは炭素数 1~3 の炭化水素基)</p> <p>で表わされる化合物を酸化剤で酸化したのち脱塩化水素反応, 次いでエステル化反応を行い, あるいはエステル化反応次いで脱塩化水素反応を行い, 更に脱塩素反応を行うことを特徴とする</p> <p>一般式</p> $ClFC=CF-CF=CF-(G)_x-C \begin{array}{l} \text{O} \\ // \\ Z \end{array}$ <p>(Gは炭素数 1 又は 2 の炭化水素基。xは 0 または 1。Zはアルコキシ基。) で示されるジエン系含フッ素化合物の製法。</p>
13	54-16091 (54. 2. 16) (福田 有近)	62-31294 (62. 7. 7) (三寿, 馬場 健二)	1433870 (63. 4. 7) (信行)	レーザ光散乱光度計	<p>1 被検出液体の散乱光強度を測定するレーザ光散乱光度計において測定セルと光トラップを中心に装着した円環スリットとをそれらの中心軸がいずれもレーザ入射光束の光軸に一致するように配し, かつ, 前記光トラップで反射された透過光成分を検出する透過光強度検出部および前記円環スリットにより限定された散乱光成分を検出する散乱光強度検出部とを設け, 更に, 前記透過光強度検出部によって検出される透過光強度の変動を検出すると共に, その変動に対応した出力信号を前記散乱光強度検出部に入力する変動解消回路を形成し, この出力信号によって, 入射光強度の変動によって生じる散乱光強度検出部の出力の変動を相殺するように構成したことを特徴とするレーザ光散乱光度計。</p>
14	57-159578 (57. 9. 16) (西崎 克巳, 森下 延男)	62-41616 (62. 9. 3)	1433960 (63. 4. 7)	艶消成型品	<p>1 (a)塩化ビニル系樹脂100重量部, (b)エチレン-酢酸ビニル共重合体の存在下, 重合温度における塩化ビニルモノマーの飽和蒸気圧未満の圧力でかつ, モノマー油滴が実質的に存在しないモノマー濃度の極めて低い状態でグラフト重合されたエチレン-酢酸ビニル共重合体-塩化ビニルグラフト共重合体 1~100重量部および (c)可塑剤30~200重量部とからなる艶消成型品。</p>
15	54-22561 (54. 3. 1) (森下 杉本 悟, 津久間孝次 保幸)	62-45167 (62. 9. 25)	1436738 (63. 4. 25)	安定化したA型ゼオライト	<p>1 一般式</p> $(aNa_2O + (1-a)MO) \cdot Al_2O_3 \cdot xSiO_2 \cdot yH_2O$ <p>(aは0.667~0.917, xは2±0.2, yは6以下であり, Mは周期律表の第II族, 第IV族元素, 遷移金属元素の内のいずれかで2価陽イオンを表わす) で表わされ, かつ活性化状態で, 25°C, 40 mmHg の n-ペンタン圧力下に於いて16時間後の n-ペンタン吸着量が1重量%以下である安定化したA型ゼオライト。</p>

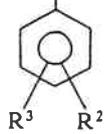
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
16	56-183038 (56. 11. 17) (上田 智, 福島 利久 小泉 光恵)	62-43927 (62. 9. 17)	1436792 (63. 4. 25)	結晶性モルデナイトの製造法	<p>1 反応組成物が酸化物のモル比で表わして次の組成</p> $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3=109\sim 240$ $\text{Na}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3=28.6\sim 67$ $\text{Q}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3=0.18\sim 2.96$ $\text{H}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3=1029\sim 2930$ <p>(ここでQはベンジルトリメチルアンモニウムイオンを表わす)</p> <p>の反応組成物を自生圧力下において70~140°Cの温度で反応させることを特徴とするハイシリカ結晶性モルデナイトの製造法。</p>
17	54-30559 (54. 3. 17) (山田 邦貴, 鈴木 祐二)	62-48681 (62. 10. 15)	1441909 (63. 5. 30)	ポリオレフィンの製造方法	<p>1 (i) マグネシウムジハロゲン化物を、一般式 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{O}-\text{R}$ (Rは炭素数1~10のアルキル基またはエーテル基やグリシジル基を含んでいるものでもよい) および/または一般式 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{O}-\text{R}'$ (R'は炭素数1~10のアルキル基, またはエーテル基, グリシジル基, ハロゲンを含んでいるものでもよい。) で示される不飽和基をもつエーテル化合物 (α位や β位の水素がアルキル基に置換されているものでもよい) および一般式 $\text{SiX}_n(\text{OR}'')_{4-n}$ (Xはハロゲン, R''はアルキル基, nは0~4の整数) で示されるケイ素化合物と機械的に接触反応させたのちチタンテトラハライドの一般式 $\text{R}^1-\text{O}-\text{R}^2$ (R¹は炭素数2~10のアルキル, R²はR¹と同じまたは異なる炭素数2~10のアルキル) および/または一般式 $\text{R}^{1'}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-\text{R}^{2'}$ (R^{1'}は炭素数1~10のアルキル, R^{2'}はR^{1'}と同じまたは異なる炭素数1~10のアルキル, 水素またはエーテル結合をもった化合物) であらわされるエーテル化合物の混合物で処理することによって得た微粒状固体,</p> <p>(ii) 有機アルミニウム化合物,</p> <p>上記(i), (ii)から成る重合触媒を用いることを特徴とするポリオレフィンの製造方法。</p>
18	54-154426 (54. 11. 30) (久保 野中 雅滋, 小山 清孝 悠次)	62-48665 (62. 10. 15)	1442330 (63. 6. 8)	α -クロロヒドロシナムニトリルの製造法	<p>1 ベンゼンと2,3-ジクロロプロピオニトリルとを、触媒成分として五塩化アンチモン、五塩化モリブデン、塩化第二鉄またはこれらの混合物を含む触媒の存在下で反応させることを特徴とする α-クロロヒドロシナムニトリルの製造法。</p> <p>2 ベンゼンと2,3-ジクロロプロピオニトリルとを、触媒成分として五塩化アンチモン、五塩化モリブデン、塩化第二鉄またはこれらの混合物を含む触媒及び助触媒としてのブロンステッド酸もしくはその水溶液またはシリカゲルの存在下で反応させることを特徴とする α-クロロヒドロシナムニトリルの製造法。</p>
19	55-132796 (55. 9. 26) (藤井 修, 井上 孝彦)	62-51898 (62. 6. 8)	1442340 (63. 6. 8)	酸化鉄の製造法	<p>1 長径が 0.4μ 以下で、かつ幅 (短径) が 0.04μ 以下の微細な針状の黄色酸化鉄 (α-FeOOH) を水又は 10N 以下のアルカリ水溶液に分散し 100~250°C で熱処理を行い、長径が $0.3\sim 1.0\mu$, 幅が 0.1μ 以下の単一粒子形状を有する結晶を得ることを特徴とする黄色酸化鉄の製造法。</p> <p>2 水酸化第一鉄の分散水溶液を pH 11 以上</p>

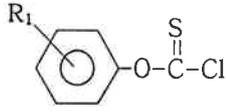
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
					<p>で空気酸化して得られる長径が 0.4μ 以下で、かつ幅が 0.04μ 以下の微細な針状の黄色酸化鉄のアルカリ水溶液分散液を $100\sim 250^\circ\text{C}$ で熱処理を行い、長径が $0.3\sim 1.0\mu$、幅が 0.1μ 以下の単一粒子形状を有する結晶を得ることを特徴とする黄色酸化鉄の製造法。</p> <p>3 長径が 0.4μ 以下で、かつ幅が 0.04μ 以下の微細な針状の黄色酸化鉄をケイ酸ソーダの存在下に水又は 10N 以下のアルカリ水溶液に分散し $100\sim 250^\circ\text{C}$ で熱処理を行い、長径が $0.3\sim 1.0\mu$、幅が 0.1μ 以下の単一粒子形状を有する結晶を得ることを特徴とする黄色酸化鉄の製造法。</p>
20	56-51770 (56. 4. 8)	62-51899 (62. 6. 8)	1442353 (63. 6. 8)	黄色酸化鉄の製造法	<p>1 水酸化第一鉄と硫酸第一鉄を $2:1\sim 4:1$ のモル比で含み、かつ全鉄分と硫酸根 (SO_4^{2-}) を $3:2\sim 5:1$ のモル比で含む水酸化第一鉄の懸濁水溶液に 60°C 以下の温度で、酸素含有ガスを導入する事を特徴とする黄色酸化鉄 ($\alpha\text{-FeOOH}$) の製造法。</p>
21	57-156710 (57. 9. 10)	62-54424 (62. 11. 14)	1444290 (63. 6. 8)	カーバメート誘導体	<p>1 一般式 (I) :</p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: right;">(I)</p> </div> <p>(式中、R_1 は炭素数 $1\sim 5$ のアルキル基を示し、R_2 は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基又は低級アルコキシ基を示し、n は 1 又は 2 を示し、X は酸素原子又は硫黄原子を示す。) で表わされるカーバメート誘導体。</p> <p>2 一般式 (II)</p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: right;">(II)</p> </div> <p>(式中、Y は水素原子、ハロカルボニル基又はハロチオカルボニル基であり、R_1 は炭素数 $1\sim 5$ のアルキル基を示す。) で表わされるフェノール誘導体を</p> <p>一般式 (III)</p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: right;">(III)</p> </div> <p>(式中、Z は (II) 式の Y が水素原子のときハロカルボニル基又はハロチオカルボニル基であり、(II) 式の Y がハロカルボニル基又はハロチオカルボニル基のとき水素原子であり、R_2 は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基又は低級アルコキシ基を示し、n は 1 または 2 を示す。) で表わされるアミノピリジン誘導体と反応させることを特徴とする。</p> <p>一般式 (I) :</p>

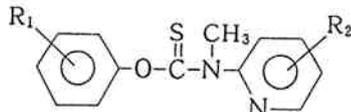
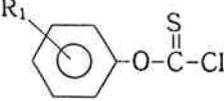
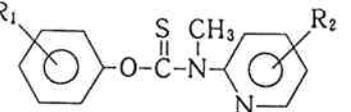
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
					 <p>(式中、R₁ は炭素数1～5のアルキル基を示し、R₂ は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基又は低級アルコキシ基を示し、nは1又は2を示し、Xは酸素原子又は硫黄原子を示す。) で表わされるカーバメート誘導体の製造法。</p> <p>3 一般式 (I) :</p>  <p>(式中、R₁ は炭素数1～5のアルキル基を示し、R₂ は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基又は低級アルコキシ基を示し、nは1又は2を示し、Xは酸素原子又は硫黄原子を示す。) で表わされるカーバメート誘導体を有効成分として含有することを特徴とする除草剤。</p>
22	56-162697 (56.10.14)	62-55839 (62.11.21)	1446840 (63.6.30)	アスパルチルフエニルアラニンアルキルエステルの製造法	1 L-アスパラギン酸及び L-フェニルアラニン低級アルキルエステルを含む培地に、アルカリゲネス属、トルロプシス属、ロドトルラ属又はスポロボロマイセス属に属する α-L-アスパルチル-L-フェニルアラニン低級アルキルエステル生産菌を培養して α-L-アスパルチル-L-フェニルアラニン低級アルキルエステルを生成させ、これを採取することを特徴とするアスパルチルフエニルアラニンアルキルエステルの製造法。
23	58-75404 (58.4.28)	62-45193 (62.9.25)	1449193 (63.7.11)	ジルコニア焼結体	1 一般式 (ZrO ₂) _{100-(x+y)} (MO) _x (ThO ₂) _y (式中 MO は Y ₂ O ₃ 又はアルカリ土類の酸化物又はランタン系希土類の酸化物の一種以上から成り、xは 2 ≤ x ≤ 15, yは 0.05 ≤ y ≤ 3 の範囲である。数値はモル%を示す。) よりなるジルコニア焼結体。
24	55-74179 (55.6.4)	62-55540 (62.11.20)	1449572 (63.7.11)	粒状加硫促進剤の製造方法	1 粉末状加硫促進剤100重量部を、2～8重量部の分子中にカルボキシル基又は水酸基を有する水溶性アニオン性高分子を含む水溶液に分散させた混合物を、アルカリ土類金属塩の少なくとも一種を含有する水溶液中に滴下造粒し、濾過、乾燥することを特徴とする粒状加硫促進剤の製造方法。
25	57-196836 (57.11.11)	62-56184 (62.11.24)	1452021 (63.7.25)	粗面化陽イオン交換膜を製造する方法	1 シリカ粉末と水とを混合し、懸濁あるいはペースト状の混合物となし、該混合物をオート紙あるいは濾紙上に担持せしめ乾燥することで形成したシリカ粉末層を陽イオン交換基及び/又は陽イオン交換基になりうる基を有するパーフルオロカーボン重合体膜の表面に加熱・圧着し、かかる膜表面に形成されたシリカ粉末を苛性アルカリ水溶液で溶出することにより得た粗面化陽イオン交換膜を1～10重量%苛性アルカ

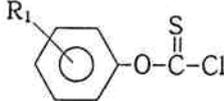
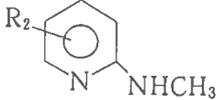
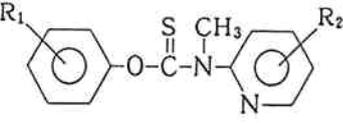
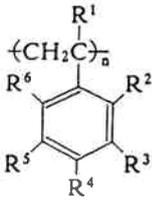
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
					リ水溶液中で沸騰処理することを特徴とする粗面化陽イオン交換膜を製造する方法。
26	58-19603 (58. 2. 10) (井川 一成, 斉藤 博行)	62-56780 (62. 11. 27)	1452031 (63. 7. 25)	臭素回収用吸着剤及びこれを用いた臭素回収方法	1 化学組成が一般式 $xM_{2/n}O \cdot Al_2O_3 \cdot ySiO_2 \cdot zH_2O$ (ここでMは価数nの陽イオン, $x=0 \sim 2, y \geq 18, z=0$ 又は正の数である) で示されるゼオライトを含有する臭素回収用吸着剤。 2 遊離した臭素を含有する水溶液又は臭素含有ガスを, 化学組成が一般式 $xM_{2/n}O \cdot Al_2O_3 \cdot ySiO_2 \cdot zH_2O$ (ここでMは価数nの陽イオン, $x=0 \sim 2, y \geq 18, z=0$ 又は正の数である) で示されるゼオライトを含有する吸着剤と接触させた後, 該吸着剤を加熱して臭素を脱着することを特徴とする臭素回収方法。
27	57-22445 (57. 2. 15) (平木 一郎, 根塚 信健, 川添 渉, 稲村 征夫, 山田 栄一) (株新潟鉄工所と共願)	62-61570 (62. 12. 22)	1454081 (63. 8. 10)	エチレンのオキシ塩素化法	1 流動化したオキシ塩素化触媒の存在する流動床反応器に塩化水素, エチレンおよび酸素もしくは酸素含有ガスを供給してオキシ塩素化反応を行なわせるに際し, 塩化水素およびエチレンを該反応器の流動触媒床における酸素もしくは酸素含有ガス供給位置の上側と下側に分割して供給し, かつ該上側の塩化水素およびエチレンの供給位置を該酸素もしくは酸素含有ガス供給位置よりも少なくとも5cm高くすることを特徴とするエチレンのオキシ塩素化法。
28	53-124666 (53. 10. 12) (山田 邦貴, 鈴木 祐二)	62-59126 (62. 12. 9)	1456272 (63. 9. 9)	ポリオレフィンの製造方法	1 チタン化合物と有機アルミニウム化合物を用いてポリオレフィンを製造するに際し, チタン化合物として, マグネシウムジハロゲン化合物を一般式 $CH_2=CH-CH_2-O-R$ (Rは炭素数1~10のアルキル基, またはエーテル基やグリシジル基を含んでいるものでもよい) および/または一般式 $CH_2=CH-O-R'$ (R'は炭素数1~10のアルキル基, またはエーテル基, グリシジル基, ハロゲンを含んでいるものでもよい。) で示される不飽和基をもつエーテル化合物 (α 位や β 位の水素がアルキル基に置換されていてもよい) および一般式 $SiX_n(OR'')_{4-n}$ (Xはハロゲン, R''はアルキル基, nは0~4の整数) で示されるケイ素化合物と機械的に接触させたのち, チタンテトラハライドにより処理した微粒状固体を用いることを特徴とするポリオレフィンの製造方法。
29	55-92293 (55. 7. 8) (小山 清孝, 木原 啓一)	62-60379 (62. 12. 16)	1456322 (63. 9. 9)	フェニルアセトアルデヒドの製造方法	1 触媒の存在下スチレンオキシドを異性化してフェニルアセトアルデヒドを製造するに当り, 触媒として酸型イオン交換樹脂を使用することを特徴とするフェニルアセトアルデヒドの製造方法。
30	55-150785 (55. 10. 29) (林 隆夫, 坂中 靖弘)	62-59741 (62. 12. 12)	146332 (63. 9. 9)	加硫促進剤組成物の製造法	1 2-メルカプトイミダゾリンと, この2-メルカプトイミダゾリンに対してそれぞれ5~45重量%の平均分子量200~10000で粘度(100°F)37000センチストークス以下の液状ポリブテン, 0.1~20重量%のノニオンまたはアニオン系界面活性剤および前記の2-メルカプトイミダゾリンと液状ポリブテンの総量当り0.1~10重量%の水溶性アニオン性高分子を含む2-メルカプトイミダゾリン混合物を, 前記水溶性アニオン性高分子と酸性条件下で水に不溶な塩を形成しうるカチオン系界面活性剤を前記の2-メルカプト

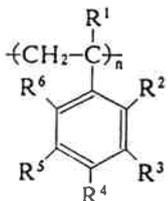
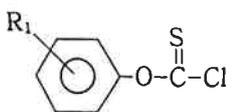
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
					<p>イミダゾリンと液状ポリブテンの総量当り0.1～10重量%含む酸性水溶液中に滴下して、均一な加硫促進剤組成物に分離することを特徴とする加硫促進剤組成物の製造法。</p> <p>2 2-メルカプトイミダゾリンと、この2-メルカプトイミダゾリンに対してそれぞれ5～45重量%の平均分子量200～10000で粘度(100°F)37000センチストークス以下の液状ポリブテン、0.1～20重量%のノニオンまたはアニオン界面活性剤、30重量%以下のプロセスオイル、エチレン-酢酸ビニル共重合体、パラフィンワックスまたは可塑剤、および前記の2-メルカプトイミダゾリン、液状ポリブテンとプロセスオイル、エチレン-酢酸ビニル共重合体、パラフィンワックスまたは可塑剤の総量当り0.1～10重量%の水溶性アニオン性高分子を含む2-メルカプトイミダゾリン混合物を、前記水溶性アニオン性高分子と酸性条件下で水に不溶な塩を形成しうるカチオン系界面活性剤を前記の2-メルカプトイミダゾリン、液状ポリブテンとプロセスオイル、エチレン-酢酸ビニル共重合体、パラフィンワックスまたは可塑剤の総量当り0.1～10重量%含む酸性水溶液中に滴下して、均一加硫促進剤組成物に分離することを特徴とする加硫促進剤組成物の製造法。</p>
31	55-163360 (55.11.21) (久保 桂川)	62-60373 (62.12.16) (雅滋, 吉光 寛二)	1456335 (63.9.9) 満明	m-フェノキシトルエ ンの側鎖の臭素化法	<p>1 臭素化剤として、 一般式</p> $\begin{array}{c} \text{W} \quad \text{Z} \\ \quad \\ \text{Br}-\text{C}-\text{C}-\text{Br} \\ \quad \\ \text{X} \quad \text{Y} \end{array}$ <p>(式中WおよびZは Cl または Br, XおよびYは Cl, Br または H を表わす。)で示されるポリハロゲン化エタンを用い、液相中で無定形炭素の存在下に m-フェノキシトルエンの臭素化を行うことを特徴とする、m-フェノキシトルエンの側鎖の臭素化法。</p>
32	56-59728 (56.4.22) (柴山 藤本)	62-60691 (62.12.17) (乾夫, 板谷 輝雄)	1456348 (63.9.9) 謹悟	放射線感応性レジスト 材料による微細加工法	<p>1 基板上に放射線感応性高分子の薄膜を形成し、放射線を照射し、現像、エッチングすることからなる微細加工法において、上記高分子が一般式、</p> $\begin{array}{c} \text{-(CH}_2\text{-CR)-} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\ \\ \text{-(CH}_2\text{NR}'_2\text{)}_n \end{array}$ <p>(但し、式中R, R' は水素またはアルキル基であり、nは置換基の数を表わす整数である)で表わされる繰り返し単位を少なくとも10重量%以上含む高分子であることを特徴とする放射線感応性レジスト材料による微細加工法。</p>

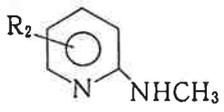
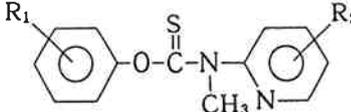
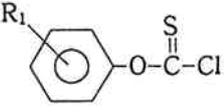
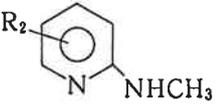
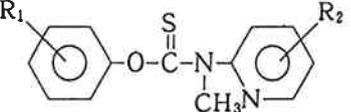
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
33	56-128133 (56. 8. 18) (松本 高德)	62-58620 (62. 12. 7) (俣博, 力武 一夫 宗忠)	1456356 (63. 9. 9)	イオン交換膜の接合方法	1 含フッ素イオン交換膜と4フッ化エチレン-パーフルオロビニルエーテル共重合体膜を接着するにあたり、接着しようとする該イオン交換膜と該重合体膜を突合せ、突合せ部上下に該重合体と同一の重合体の帯状膜をおき、ヒートシーラーを用いて温度 200~350°C、接着面にかかる圧力 3~20 kg/cm ² 、時間 5~300秒で接着することを特徴とする含フッ素イオン交換膜の4フッ化エチレン-パーフルオロビニルエーテル共重合体膜との接合方法。
34	56-139247 (56. 9. 5) (原田 恒夫, 竹本 五十嵐辰夫)	62-57317 (62. 11. 30)	1456358 (63. 9. 9)	アスパルチルフエニルアラニンアルキルエステルの製造法	1 L-アスパラギン酸及び L-フェニルアラニン低級アルキルエステルを含む培地に、シュードモナス属に属する α-L-アスパルチル-L-フェニルアラニン低級アルキルエステル生産菌を培養して α-L-アスパルチル-L-フェニルアラニン低級アルキルエステルを生成させ、これを採取することを特徴とするアスパルチルフエニルアラニンアルキルエステルの製造法。
35	56-140905 (56. 9. 9) (渡辺 博幸)	62-56236 (62. 11. 25)	1456359 (63. 9. 9)	塩素化ポリビニル芳香族化合物の製造方法	1 一般式 $\left(\text{CH}_2 - \underset{\text{C}_6\text{H}_3}{\overset{\text{R}^1}{\text{C}}} \right)_n$  (但し、R ¹ , R ² , R ³ は水素又は C ₁ ~C ₆ の低級アルキル基から選ばれ、R ¹ , R ² , R ³ は同一あるいは異っていてもよい、nは50ないし3万の整数から選ばれる。) で表わされるポリビニル芳香族化合物を有機溶媒に溶解させ、塩素イオンを含む水溶液共存下に電解反応を行い、塩素化ポリビニル芳香族化合物を製造する方法。
36	56-148754 (56. 9. 22) (小山 萩)	62-57318 (62. 11. 30) (清孝, 入野 規男)	1456361 (63. 9. 9)	ジペプチドエステルとアミノ酸エステルとの付加化合物の回収法	1 一般式 $\text{R}_1 - \text{O} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \underset{\text{R}_1}{\text{CH}} - \text{NH}_2 \cdot \text{HO} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - (\text{CH}_2)_n - \text{CH} - \overset{\text{NHXO}}{\parallel} \text{C} - \underset{\text{R}_1}{\text{NH}} - \text{CH} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{OR}_1$ で表わされるジペプチドエステルとアミノ酸エステルとの付加化合物 (式中 R ₁ は低級アルキル基、R ₂ はアミノ酸の側鎖基、Xは置換基を有することのあるベンジルオキシカルボニル基であり、nは1又は2である) を固相で含み、かつ蛋白分解酵素を含む水性混合液に水と二相を形成することのできる有機溶媒を加えて混合し、この付加化合物の実質的部分を固相で含む有機溶媒相と酵素を含む水相の二液相を形成させ、有機溶媒相と水相を分離し、この付加化合物を有機溶媒のスラリーとして回収し、水相から酵素を回収することを特徴とするジペプチドエステルとアミノ酸エステルとの付加化合物の回収法。

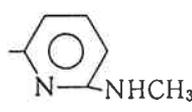
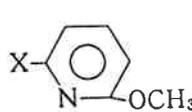
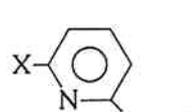
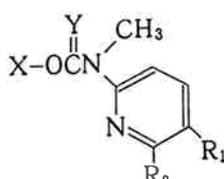
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
37	57-59591 (57. 4. 12) (中川 清田)	62-58622 (62. 12. 7) (修, 折坂 徹)	1456377 (63. 9. 9) 克則	陽イオン交換膜に金属を固着せしめる方法	1 陽イオン交換膜に、還元剤を含浸せしめたのち、溶液中の負の金属錯体イオンを形成する金属塩を含浸せしめ、化学メッキすることを特徴とする陽イオン交換膜に金属を固着せしめる方法。
38	57-88830 (57. 5. 27) (続木 森中)	61-55908 (61. 11. 29) 建治, 魚谷 秀夫)	1456383 (63. 9. 9) 武	2-アルコキシ-6-クロロピリジン類の製造法	1 2, 6-ジクロロピリジンをアルカリ金属水酸化物存在下、低級アルコールと反応させることを特徴とする2-アルコキシ-6-クロロピリジン類の製造法。
39	57-96975 (57. 6. 8) (毛利 隆)	62-61676 (62. 12. 22)	1456384 (63. 9. 9)	電解用電極	1 金属からなる基体表面に、可溶性含硫黄化合物を含むニッケルメッキ浴中に、フッ素樹脂を分散させたメッキ浴を用い分散メッキをほどこしてなる電解用電極。
40	57-103909 (57. 6. 18) (竹林 忠夫, 工藤 正行)	62-59042 (62. 12. 9)	1456387 (63. 9. 9)	加湿された高濃度酸素ガスの製造法	1 あらかじめ水分を吸着した吸着剤の充填層に高濃度酸素ガスを導入し吸着水分を該ガスに同伴させて充填層から排出させることを特徴とする加湿された高濃度酸素ガスの製造方法。
41	57-125037 (57. 7. 20) (川添 渉, 押見 強, 依田 勝男, 賀谷 良寛, 中島 充幸) (株)新潟鉄工所と共願)	62-61571 (62. 12. 22)	1456388 (63. 9. 9)	エチレンのオキシ塩素化方法	1 流動化したオキシ塩素化触媒の存在する流動床反応器に塩化水素、エチレンおよび酸素もしくは酸素含有ガスを供給してオキシ塩素化反応を行わせるに際し、塩化水素およびエチレンを該反応器における酸素もしくは酸素含有ガス供給位置の上側の流動触媒床において、かつ最下段の塩化水素およびエチレンの供給位置を該酸素もしくは酸素含有ガス供給位置(該酸素もしくは酸素含有ガス供給位置が分散板の下にあるときは分散板)よりも少なくとも5 cm 高くすることを特徴とするエチレンのオキシ塩素化方法。
42	57-125848 (57. 7. 21) (中川 坂中)	62-58609 (62. 12. 7) 辰司, 鳴井 靖弘)	1456389 (63. 9. 9) 衛	耐寒性のすぐれたクロロスルホン化ポリエチレンの製造法	1 ポリエチレンをハロゲン化炭素水素溶媒に溶解し、均一な溶液とした後、該溶液の温度を低下させることにより、ポリエチレンの溶解温度領域あるいはそれよりも低い温度領域においてポリエチレンが均一に溶解した溶液とし、ラジカル発生剤を触媒として、塩化スルフリルと反応させることを特徴とする耐寒性のすぐれたクロロスルホン化ポリエチレンの製造法。
43	57-181408 (57. 10. 18) (有家 田村)	63-1244 (63. 1. 12) 潤二, 板橋 芳夫)	1456394 (63. 9. 9) 慶治	L型ゼオライトの製造方法	1 L型ゼオライトの製造方法に於て無水換算で珪素成分を SiO ₂ として 67~91 wt% 含有する無定形アルミノ珪酸ナトリウム化合物を水酸化カリウム水溶液中で結晶化することを特徴とする方法。
44	58-176406 (58. 9. 26) (続木 橋濱)	63-429 (63. 1. 7) 建治, 魚谷 充幸)	1456404 (63. 9. 9) 武	チオカーバメート誘導体の製造法	1 一般式 (I)  <div style="text-align: right;">(I)</div> <p>(式中 R₁ は炭素数 2~5 のアルキル基を示す。) で表わされるアルキルフェニルクロロチオホルメイトと</p>

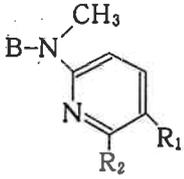
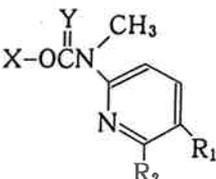
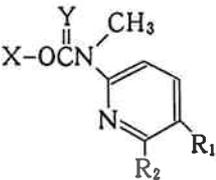
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
45	58-176407 (58. 9. 26) (続木 橋濱)	63-430 (63. 1. 7) 建治, 魚谷 充幸)	1456405 (63. 9. 9) 武	チオカーバメート誘導 体の製造方法	<p>一般式 (II)</p>  <p>(II)</p> <p>(式中 R₂ は水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基及び低級アルコキシ基を示す。) で表わされるアミノピリジン誘導体を脱ハロゲン化水素試剤の存在下に, ヘキサン-水混合溶媒中で反応させることを特徴とする</p> <p>一般式 (III)</p>  <p>(III)</p> <p>(式中 R₁, R₂ は前に同じ。) で表わされるチオカーバメート誘導体の製造法。</p> <p>1 一般式 (I)</p>  <p>(I)</p> <p>(式中 R₁ は炭素数 2~5 のアルキル基を示す。) で表わされるアルキルフェニルクロロチオホルメイトと</p> <p>一般式 (II)</p>  <p>(II)</p> <p>(式中 R₂ は水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基を示す。) で表わされるアミノピリジン誘導体を脱ハロゲン化水素試剤の存在下にエタノール中で反応させ次いで水を添加することを特徴とする</p> <p>一般式 (III)</p>  <p>(III)</p> <p>(式中 R₁, R₂ は前に同じ。) で表わされるチオカーバメート誘導体の製造法。</p>

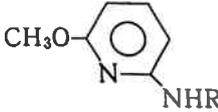
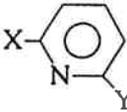
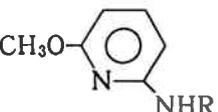
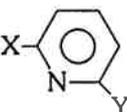
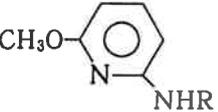
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
46	58-245527 (58.12.28) (高橋 堅二, 赤沢 道博)	62-60472 (62.12.16)	1456410 (63.9.9)	滴下器	1 一体化された液受槽の上部に有孔挿入部材が挿入された複数の液滴下穴を有する複数の滴下盤がそれぞれ電氣的に接続されずに独立に存在し、該滴下盤及びその側面より挿入された、単位電解槽より連絡された1ケの滴下盤につき1ケの挿入管がそれぞれ液受槽とは分割されて存在し、使用に際してそれらが一体化された構成よりなることを特徴とする滴下器。
47	59-10317 (59.1.25) (高橋 堅二, 赤沢 道博)	62-60473 (62.12.16)	1456414 (63.9.9)	滴下器	1 一体化された液受槽の上部に有孔挿入部材が挿入された複数の液滴下穴を有する複数の滴下盤がそれぞれ電氣的に接続されずに独立に存在し、該滴下盤、及び単位電解槽より連絡された1ケの滴下盤につき1ケの挿入管が挿入されたフタがそれぞれ液受槽とは分割されて存在し、使用に際してそれらが一体化された構成よりなることを特徴とする滴下器。
48	59-27253 (59.2.17) (統木 建治, 魚谷 充幸) 橋濱 武	63-431 (63.1.7)	1456415 (63.9.9)	チオカーバメート誘導体の製造方法	<p>1 一般式 (I)</p>  <p style="text-align: right;">(I)</p> <p>(式中 R₁ は炭素数 2~5 のアルキル基を示す。) で表わされるアルキルフエニルクロロチオホルメイトと</p> <p>一般式 (II)</p>  <p style="text-align: right;">(II)</p> <p>(式中 R₂ は水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基を示す。) で表わされるアミノピリジン誘導体を炭酸ナトリウムの存在下にメタノール中で反応させ次いで水を添加することを特徴とする</p> <p>一般式 (III)</p>  <p style="text-align: right;">(III)</p> <p>(式中 R₁, R₂ は前記に同じ。) で表わされるチオカーバメート誘導体の製造方法。</p>
49	59-51069 (59.3.19) (渡辺 博幸, 清田 徹)	62-58605 (62.12.7)	1456417 (63.9.9)	塩素化ポリビニル芳香族化合物の製造法	<p>1 一般式</p>  <p>[但し, R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶ は水素又は C₁</p>

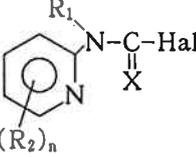
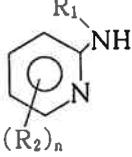
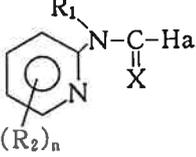
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
					<p>~C₆ の低級アルキル基から選ばれ同一あるいは異なる基を示す。また、R⁴, R⁵; R⁵, R⁶ は</p> $\begin{array}{c} -C=C-C=C- \\ \quad \quad \quad \\ R^7 \quad R^8 \quad R^9 \quad R^{10} \end{array}$ <p>(R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰ はH又は C₁~C₆ の低級アルキル基から選ばれ同一あるいは異なる基を示す) で環を形成していてもよい。] で表わされるポリビニル芳香族化合物を芳香族系有機溶媒に溶解させ、塩素イオンを含む水溶液共存下に通電を行うことを特徴とする塩素化ポリビニル芳香族化合物の製造法。</p>
50	59-123674 (59. 6. 18)	62-58606 (62. 12. 7)	1456419 (63. 9. 9)	臭素化ポリビニル芳香族化合物の製造法	<p>1 一般式</p>  <p>[但し、R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶ は水素又は C₁~C₆ の低級アルキル基から選ばれ、同一あるいは異なっているいてもよい。また、R⁴, R⁵; R⁵, R⁶ は</p> $\begin{array}{c} -C=C-C=C- \\ \quad \quad \quad \\ R^7 \quad R^8 \quad R^9 \quad R^{10} \end{array}$ <p>(R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰ は水素又は C₁~C₆ の低級アルキル基から選ばれ、同一あるいは異なっているいてもよい。) で環を形成していてもよい。n は 50~30000 の整数から選ばれる。] で表わされるポリビニル芳香族化合物を有機溶媒に溶解させ、臭素イオンを含む水溶液共存下で通電を行うことを特徴とする臭素化ポリビニル芳香族化合物の製造法。</p>
51	59-123675 (59. 6. 18)	62-58607 (62. 12. 7)	1456420 (63. 9. 9)	臭素化ポリビニルトルエンの製造法	<p>1 ビニルトルエンモノマーを一般式 RM (R はアルキル, アリールあるいはアラルキル基から選ばれ, M はリチウム, ナトリウムあるいはカリウムから選ばれる) で表わされる有機金属存在下に重合し, 該重合体溶液と臭素イオンの存在する水溶液共存下に通電を行う臭素化ポリビニルトルエンの製造法。</p>
52	59-132045 (59. 6. 28)	63-432 (63. 1. 7)	1456423 (63. 9. 9)	チオカーバメート誘導体の製造法	<p>1 一般式 (I)</p>  <p>(式中 R₁ は炭素数 2~5 のアルキル基を示す。) で表わされるアルキルフェニル クロロチオホルメイトと</p>

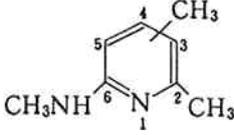
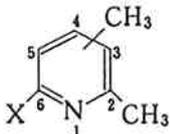
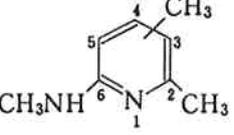
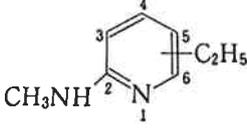
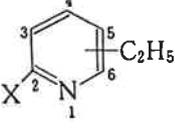
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
					<p>一般式 (II)</p>  <p>(II)</p> <p>(式中 R₂ は水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基を示す。) で表わされるアミノピリジン誘導体を脱ハロゲン化水素試剤存在下に含水或いは無水の炭素数 4 或いは 5 の 2 級或いは 3 級アルコール中で反応させ次いで水を添加することを特徴とする</p> <p>一般式 (III)</p>  <p>(III)</p> <p>(式中 R₁, R₂ は前に同じ。) で表わされるチオカーバメート誘導体の製造法。</p>
53	59-137912 (59. 7. 5) (続木 村上)	63-433 (63. 1. 7) (建治 充幸)	1456424 (63. 9. 9) (魚谷 武)	チオカーバメート誘導体の製造法	<p>I 一般式 (I)</p>  <p>(I)</p> <p>(式中 R₁ は炭素数 2 ~ 5 のアルキル基を示す。) で表わされるアルキルフエニルクロロチオホルメイトと</p> <p>一般式 (II)</p>  <p>(II)</p> <p>(式中 R₂ は水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基を示す。) で表わされるアミノピリジン誘導体を脱ハロゲン化水素試剤存在下に含水或いは, 無水のイソプロパノール中で反応させ次いで水を添加することを特徴とする</p> <p>一般式 (III)</p>  <p>(III)</p> <p>(式中 R₁, R₂ は前に同じ。) で表わされるチオカーバメート誘導体の製造法。</p>

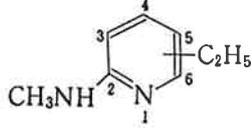
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
54	55-107093 (55. 8. 6)	63-5329 (63. 2. 3)	1458794 (63. 9. 28)	アンモニアを回収する 方法	1 重炭酸イオンを含む塩化アンモニウム水溶液に固体の食塩及び該水溶液と二液相を形成し得る第一級アミンを加え、さらにこれに不活性ガス又は/および炭酸ガスを供給して反応せしめ、しかるのち二液相を分離する事により該水溶液中の塩化アンモニウムをアンモニアに転化せしめて回収する方法。
55	57-118620 (57. 7. 9)	63-2549 (63. 1. 19)	1458844 (63. 9. 28)	2-メトキシ-6-メチル アミノピリジンの製造 法	1 一般式  (式中Xは臭素原子又は塩素原子を示す。) で表わされる2-ハロ-6-メチルアミノピリジンとメタノールをアルカリ金属水酸化物の存在下に反応させることを特徴とする2-メトキシ-6-メチルアミノピリジンの製造法。
56	57-230769 (57. 12. 28)	63-2550 (63. 1. 19)	1458860 (63. 9. 28)	2-メトキシ-6-メチル アミノピリジンの製造 法	1 一般式  (式中Xは臭素原子又は塩素原子を示す。) で表わされる2-ハロ-6-メトキシピリジンを銅或いは銅化合物の存在下メチルアミンと反応させることを特徴とする2-メトキシ-6-メチルアミノピリジンの製造法。
57	58-35989 (58. 3. 7)	63-2551 (63. 1. 19)	1458862 (63. 9. 28)	2-ジメチルアミノ-6- メチルアミノピリジン 及びその製造法	1 2-ジメチルアミノ-6-メチルアミノピリジン。 2 一般式  (式中Xは臭素原子あるいは塩素原子を示す。) で表わされる2-ハロ-6-メチルアミノピリジンとジメチルアミンを反応させることを特徴とする2-ジメチルアミノ-6-メチルアミノピリジンの製造法。
58	58-69242 (58. 4. 21)	63-2557 (63. 1. 19)	1458864 (63. 9. 28)	カーバメート誘導体	1 一般式 (I) :  (I) (式中、Xは2-ナフチル基、5-インダニル基、5,6,7,8-テトラヒドロ-2-ナフチル基または低級アルキル基を有するフェニル基を示し、Yは

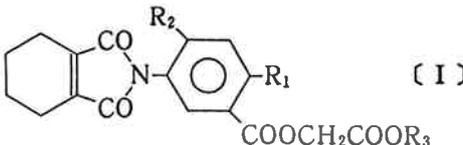
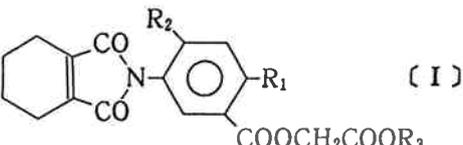
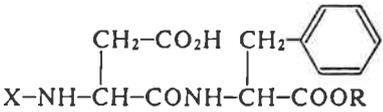
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
					<p>酸素原子または硫黄原子を示し、R_1 は水素原子またはニトロ基を示し、R_2 は低級アルキルアミノ基を示す。) で表わされるカーバメート誘導体。</p> <p>2 一般式 (II) :</p> $\text{X-OA} \quad (\text{II})$ <p>(式中、Aは水素原子、ハロカルボニル基またはハロチオカルボニル基であり、Xは2-ナフチル基、5-インダニル基、5,6,7,8-テトラヒドロ-2-ナフチル基または低級アルキル基を有するフェニル基を示す。) で表わされるフェノール誘導体を</p> <p>一般式 (III) :</p> <div style="text-align: center;">  <p>(III)</p> </div> <p>(式中、Bは(II)式のAが水素原子のときハロカルボニル基またはハロチオカルボニル基であり、(II)式のAがハロカルボニル基またはハロチオカルボニル基のとき水素原子であり、R_1 は水素原子またはニトロ基を示し、R_2 は低級アルキルアミノ基を示す。) で表わされるアミノピリジン誘導体と反応させることを特徴とする</p> <p>一般式 (I) :</p> <div style="text-align: center;">  <p>(I)</p> </div> <p>(式中、Xは2-ナフチル基、5-インダニル基、5,6,7,8-テトラヒドロ-2-ナフチル基または低級アルキル基を有するフェニル基を示し、Yは酸素原子または硫黄原子を示し、R_1 は水素原子またはニトロ基を示し、R_2 は低級アルキルアミノ基を示す。) で表わされるカーバメート誘導体の製造法。</p> <p>3 一般式 (I) :</p> <div style="text-align: center;">  <p>(I)</p> </div> <p>(式中、Xは2-ナフチル基、5-インダニル基、5,6,7,8-テトラヒドロ-2-ナフチル基または低級アルキル基を有するフェニル基を示し、Yは酸素原子または硫黄原子を示し、R_1 は水素原子またはニトロ基を示し、R_2 は低級アルキル</p>

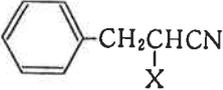
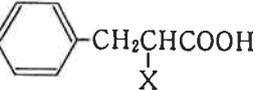
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
59	58-73857 (58. 4. 28) (続木	63-2552 (63. 1. 19) 建治,	1458865 (63. 9. 28) 森中 秀夫)	2-アルキルアミノ-6- メトキシピリジン及び その製造法	<p>アミノ基を示す。) で表わされるカーバメート誘導体を有効成分として含有することを特徴とする除草剤。</p> <p>1 一般式</p>  <p>(式中Rはエチル基, n-プロピル基又は iso-プロピル基を示す。) で表わされる2-アルキルアミノ-6-メトキシピリジン。</p> <p>2 一般式</p>  <p>(式中Xは臭素原子又は塩素原子, Yはアルキルアミノ基を示す。) で表わされる2-置換-6-ハロピリジンを, メタノールと反応させることを特徴とする</p> <p>一般式</p>  <p>(式中Rはエチル基, n-プロピル基又は iso-プロピル基を示す。) で表わされる2-アルキルアミノ-6-メトキシピリジン類の製造法。</p> <p>3 一般式</p>  <p>(式中Xは臭素原子又は塩素原子, Yはメトキシ基を示す。) で表わされる2-置換-6-ハロピリジンを, RNH₂ (式中Rはエチル基, n-プロピル基又は iso-プロピル基を示す。) で表わされるアミン類と反応させることを特徴とする</p> <p>一般式</p>  <p>(式中Rはエチル基, n-プロピル基又は iso-プロピル基を示す。) で表わされる2-アルキルアミノ-6-メトキシピリジン類の製造法。</p>

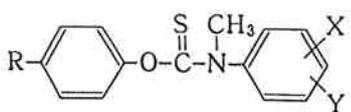
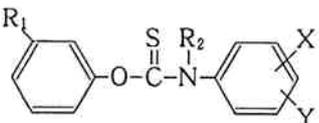
No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
60	58-121006 (58. 7. 5) (続木 橋濱)	63-2553 (63. 1. 19) (建治, 魚谷 充幸)	1458868 (63. 9. 28) 武	2-メトキシ-6-メチル アミノピリジンの製造 法	1 2, 6-ジハロピリジンとメチルアミンをメ タノール中で反応させ、次いでアルカリ金属水 酸化物を添加した後過剰のメチルアミンを除去 し得られた反応液をさらに加熱することを特徴 とする2-メトキシ-6-メチルアミノピリジンの 製造法。
61	58-165246 (58. 9. 9) (中西 続木 橋濱)	63-2558 (63. 1. 19) (明, 野中 建治, 森中 充幸, 魚谷 武)	1458870 (63. 9. 28) 悠次 秀夫 武)	カーバモイル ハライ ド誘導体	<p>1 一般式 (I)</p>  <p>(I)</p> <p>(式中, R₁ は低級アルキル基を示し, R₂ はハ ロゲン原子, 低級アルキル基又は低級アルコキ シ基を示し, n は1または2を示し, Xは酸素 原子または硫黄原子を示し, Hal はハロゲン原 子を示す。) で表わされるカーバモイル ハラ イド誘導体。</p> <p>2 一般式 (II)</p>  <p>(II)</p> <p>(式中, R₁ は低級アルキル基を示し, R₂ はハ ロゲン原子, 低級アルキル基又は低級アルコキ シ基を示し, n は1または2を示す。) で表わ される2-アルキルアミノピリジン誘導体をホス ゲン, チオホスゲン又はトリクロロメチル ク ロロホーメイトと反応させることを特徴とする 一般式 (I)</p>  <p>(I)</p> <p>(式中, R₁ は低級アルキル基を示し, R₂ はハ ロゲン原子, 低級アルキル基又は低級アルコキ シ基を示し, n は1または2を示し, Xは酸素 原子または硫黄原子を示し, Hal はハロゲン原 子を示す。) で表わされるカーバモイル ハラ イド誘導体の製造法。</p>
62	58-219477 (58. 11. 24) (続木 橋濱)	63-2554 (63. 1. 19) (建治, 魚谷 充幸)	1458874 (63. 9. 28) 武	2-メトキシ-6-メチル アミノピリジンの製造 法	1 2, 6-ジハロピリジンとメチルアミンを水 中で反応させ、熱時に水層と有機層を分離し、 該有機層とメタノールをアルカリ金属水酸化物 存在下に反応させることを特徴とする2-メトキ シ-6-メチルアミノピリジンの製造法。

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
63	58-220561 (58.11.25) (森中 中西)	63-2555 (63.1.19) (秀夫, 野中 明)	1458875 (63.9.28) 悠次	メチルアミノピリジン 誘導体	<p>1 一般式 (I)</p>  <p>(I)</p> <p>(式中, メチル基の置換位置は3位または4位である。)と表わされるメチルアミノピリジン誘導体。</p> <p>2 一般式 (II)</p>  <p>(II)</p> <p>(式中, Xは臭素原子または塩素原子を示し, メチル基の置換位置は3位または4位である。)で表わされるハロピリジン誘導体と, メチルアミンとを反応させることを特徴とする一般式 (I)</p>  <p>(I)</p> <p>(式中, メチル基の置換位置は3位または4位である。)で表わされるメチルアミノピリジン誘導体の製造法。</p>
64	58-220562 (58.11.25) (森中 中西)	63-2556 (63.1.19) (秀夫, 野中 明)	1458876 (63.9.28) 悠次	メチルアミノピリジン 誘導体	<p>1 一般式 (I)</p>  <p>(I)</p> <p>(式中, エチル基の置換位置は4位または6位である。)で表わされるメチルアミノピリジン誘導体。</p> <p>2 一般式 (II)</p>  <p>(II)</p> <p>(式中, Xは臭素原子または塩素原子を示し, エチル基の置換位置は4位または6位である。)で表わされるハロピリジン誘導体と, メチルアミンとを反応させることを特徴とする一般式 (I)</p>

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発明の名称	要旨
					 <p style="text-align: right;">(I)</p> <p>(式中、エチル基の置換位置は4位または6位である。) で表わされるメチルアミノピリジン誘導体の製造法。</p>
65	59-24322 (59. 2. 14) (続木 橋濱)	63-2955 (63. 1. 21) (建治, 魚谷 充幸)	1458878 (63. 9. 28) 武	2-ジメチルアミノ-6-メチルアミノピリジンの製造法	1 2,6-ジハロピリジンとメチルアミンを水中で反応させ、熱時に水層と有機層を分離し、該有機層とジメチルアミンを反応させることを特徴とする2-ジメチルアミノ-6-メチルアミノピリジンの製造法。
66	57-102998 (57. 6. 17) (朱山 赤沢)	62-56182 (62. 11. 24) (秀雄, 清田 徹 道博, 川寄 信弘)	1462253 (63. 10. 14) 徹	表面粗面な陽イオン交換膜の製造法	<p>1 少なくとも片面がカルボン酸基含有フッ素系陽イオン交換重合体で構成されたフッ素系陽イオン交換膜の該カルボン酸基含有フッ素系陽イオン交換重合体の層の表面に研磨材を吹きつけて該表面を研磨してこれを粗面化する表面粗面な陽イオン交換膜の製造法において、該カルボン酸基含有フッ素系陽イオン交換重合体の層が</p> <p style="text-align: center;">一般式</p> $\begin{array}{c} -X- \\ \\ \text{COOM} \end{array}$ <p>(式中Xはイオン交換基以外の構造単位を表わし、Mは水素、アルカリ金属又はアンモニウム基を表わす) で表わされる第一の末端構造の層と</p> <p style="text-align: center;">一般式</p> $\begin{array}{c} -Y- \\ \\ \text{COOR} \end{array}$ <p>(式中Yはイオン交換基以外の構造単位を表わし、Rは炭素数1ないし5のアルキル基を表わす) で表わされる第二の末端構造の層からなり、この両層が表面に実質的に平行で、かつ第一の末端構造の層が研磨すべき表面を構成するように配置された膜を用いて研磨を行い、研磨後、第二の末端構造の層を加水分解してこれを第一の末端構造に変換する事の特徴とする表面粗面な陽イオン交換膜の製造法。</p>
67	57-116887 (57. 7. 7) (中川 坂中)	62-58608 (62. 12. 7) (辰司, 鳴井 靖弘)	1462255 (63. 10. 14) 衛	クロロスルホン化ポリエチレンの製造法	1 四塩化炭素に溶解したポリエチレンを、ラジカル発生剤を触媒とし、アミン化合物を助触媒として塩化スルフリルと反応させることにより、クロロスルホン化ポリエチレンを製造する方法において、該反応の終了後、気化せしめることによりクロロスルホン化ポリエチレンと分離した四塩化炭素を、ゼオライトと接触させ、該四塩化炭素中に含まれる助触媒のアミン化合物と水分を選択的に除去し、再使用することの特徴とするクロロスルホン化ポリエチレンの製

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
					造法。
68	55-145083 (55.10.18)	63-8748 (63.2.24)	1463648 (63.10.28)	蛋白質加水分解酵素の 活性増強方法 (井上 國世, 瀬戸 弘司)	1 金属プロテアーゼの存在下, 水性媒体中で 酵素反応によってペプチド結合の生成または切 断を行うにあたり, この水性媒体中にメチルア ミンまたはメチレンジアミンを添加することを 特徴とする蛋白質加水分解酵素の活性増強方法。
69	53-19713 (53.2.24)	63-12073 (63.3.17)	1465736 (63.11.10)	3-アミノ-3-デオキシ ヘキソースの製造法 (服部憲治郎, 小野塚茂晴 戸田不二雄)	1 C-3 位の水酸基がアミノ基で置換された ヘキソース単位を含むアミノシクロデキストリン を加水分解することを特徴とする3-アミノ-3 -デオキシヘキソースの製造法。
70	58-63643 (58.4.13)	63-11622 (63.3.15)	1465815 (63.11.10)	含フッ素重合体の末端 基の定量方法 (岡田 忠司, 生重 哲男 藤本 浩之)	1 沸点 150°C 以上の非ベンゼン系極性溶媒 の1種以上からなる溶液に浸漬した試料を核磁 気共鳴装置に供し, 測定温度 150°C 以上, デ ッドタイムを 100 μsec 以下で測定すること を特徴とする主鎖がパーフルオロカーボン重合 体からなる含フッ素重合体の末端基の定量方法。
71	58-215687 (58.11.16)	63-13987 (63.3.29)	1467549 (63.11.30)	水田用除草剤 (赤平 麓郎, 染谷 進三 野中 悠次, 伊藤 幹雄 中西 明) (アグロカネショウと共願)	1 一般式〔I〕  〔I〕 〔式中 R ₁ は塩素原子または臭素原子を表わし, R ₂ は水素原子, 弗素原子または塩素原子 を表わし, R ₃ は炭素原子数 6~12のアルキル 基を表わす。〕で表わされる N-置換フェニル- 3,4,5,6-テトラヒドロフタルイミド誘導体。 2 一般式〔I〕  〔I〕 〔式中 R ₁ は塩素原子または臭素原子を表わし, R ₂ は水素原子, 弗素原子または塩素原子 を表わし, R ₃ は炭素原子数 6~12のアルキル 基を表わす。〕で表わされる N-置換フェニル- 3,4,5,6-テトラヒドロフタルイミド誘導体を有 効成分として含有することを特徴とする水田用 除草剤。
72	56-173087 (56.10.30)	63-13931 (63.3.28)	1467660 (63.11.30)	炭化珪素粉末の製造方 法 (長田 真司, 笠井 清 月館 隆明)	1 含窒素シラン化合物と炭素の混合粉末を非 酸化性雰囲気中で加熱することを特徴とする炭 化珪素粉末の製造方法。
73	53-91833 (53.7.27)	62-56857 (62.11.27)	1468596 (63.11.30)	アミノ酸エステルの光 学分割法 (野中 悠次, 小山 清孝 伊藤 幹雄) (㈱相模中央化学研究所, 味 の素㈱と共願)	1 ラセミ体アミノ酸エステルと, 一般式 

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
					(式中Xはベンジルオキシカルボニル基又はp-メトキシベンジルオキシカルボニル基を、Rは低級アルキル基を表わす)で示されるN-置換α-L-アスパルチル-L-フェニルアラニンアルキルエステルとを溶液中で混合して反応させ、N-置換α-L-アスパルチル-L-フェニルアラニンアルキルエステルとラセミ体アミノ酸エステルのD-体との付加化合物を析出させ、これを分離することを特徴とするアミノ酸エステルの光学分割法。
74	54-127363 (54.10.4) (藤井 魚谷)	63-17103 (63.4.12) (修, 高野 武, 岩本)	1470925 (63.12.14) (操 英次)	有機顔料の精製法	1 キナクリドン系顔料, アゾ系顔料, 縮合アゾ系顔料, キノフタロン系顔料, ペリレン系顔料およびフラベンスロン系顔料からなる群から選ばれた有機顔料を芳香族炭化水素溶剤に分散し, これにアルカリ金属又はアルカリ土類金属のアルコラート又は水酸化物とアルコール及び/又は水とを添加し, 該顔料のアルカリ塩を形成し, 次いでこれを酸又は水を用いて加水分解することを特徴とする有機顔料の精製法。
75	55-62746 (55.5.14) (久保 野中)	63-16374 (63.4.8) (雅滋, 小山 悠次)	1470935 (63.12.14) (清孝)	α-ハロゲノ-β-フェニルプロピオン酸の製造法	1 一般式  (式中Xはハロゲン原子を表わす)で示されるα-ハロゲノ-β-フェニルプロピオニトリルを鉍酸および酢酸または鉍酸およびプロピオン酸の存在下で加水分解することを特徴とする一般式  (Xは上記Xと同じ意味を表わす)で示されるα-ハロゲノ-β-フェニルプロピオン酸の製造法。
76	56-83792 (56.6.2) (久保)	63-14695 (63.4.1) (雅滋, 吉光)	1470948 (63.12.14) (満明)	高純度フェノキシベンズアルデヒドの製造法	1 フェノキシベンジルアルコールを水に不溶の有機溶媒中, 相間移動触媒の存在下で次亜ハロゲン酸塩水溶液と接触させて酸化し, フェノキシベンズアルデヒドを生成させ, 生成したフェノキシベンズアルデヒドを含む有機相を水相と分液し, これを塩基性水溶液で抽出洗浄し, 得られた有機相から高純度フェノキシベンズアルデヒドを回収することを特徴とする高純度フェノキシベンズアルデヒドの製造法。
77	57-197690 (57.11.12) (大貝 竹重)	63-16420 (63.4.8) (理治, 清田 浩佑, 朱山)	1470968 (63.12.14) (徹 秀雄)	粗面化陽イオン交換膜の製法	1 シリカ粉末と水とを混合し, 懸濁あるいはペースト状の混合物となし, 該混合物をアート紙あるいは濾紙上に担持せしめ, 乾燥することで形成したシリカ粉末層を, 陽イオン交換基及び/又は陽イオン交換基になりうる基を有するパーフルオロカーボン重合体膜の表面に加熱, 圧着し, かかる膜表面に形成されたシリカ粉末を苛性アルカリ水溶液で溶出することにより得た粗面化陽イオン交換膜を, 苛性アルカリ水溶

No.	出願番号 (出願月日)	公告番号 (公告月日)	登録番号 (登録月日)	発 明 の 名 称	要 旨
78	57-141712 (57. 8. 17) (竹松 森中 中西 橋濱)	63-18921 (63. 4. 20) 哲夫, 近内 秀夫, 野中 明, 統木 充幸, 魚谷	1472007 (63. 12. 27) 誠登 悠次 建治 武)	チオカーバメート誘導 体を含有する除草剤	<p>液と C₁~C₃ の低級アルコールとの混合液中で、 40°C 以上から C₁~C₃ の低級アルコールの沸 点までの温度に加熱することを特徴とする粗面 化陽イオン交換膜の製法。</p> <p>1 一般式 (I) :</p>  <p>(I)</p> <p>(式中, Rは炭素数1~5のアルキル基を示し, XおよびYは水素原子, ハロゲン原子, 低級ア ルキル基, 低級アルコキシ基またはトリフルオ ロメチル基を示す。) で表わされるチオカーバ メート誘導体を含有する除草剤。</p>
79	58-14596 (58. 2. 2) (竹松 森中 中西 橋濱)	63-18922 (63. 4. 20) 哲夫, 近内 秀夫, 野中 明, 統木 充幸, 魚谷	1472010 (63. 12. 27) 誠登 悠次 建治 武)	チオカーバメート誘導 体を含有する除草剤	<p>1 一般式 (I) :</p>  <p>(I)</p> <p>(式中, R₁ および R₂ は低級アルキル基を示 し, XおよびYは各々水素原子, ハロゲン原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基またはトリ フルオロメチル基を示す。R₁ と R₂ 及びXと Yは互に同一または相異なる。) で表わされる チオカーバメート誘導体を有効成分として含有 することを特徴とする除草剤。</p>